

1. 芯片特征

- (1) SIPOS和GPP双层钝化保护工艺
- (2) 单台面外沟槽工艺
- (3) $V_{RRM} \geq 1000V$
- (4) 正面金属层:AL或Ti-Ni-Ag
- (5) 背面金属层:Ti-Ni-Ag

2. 芯片尺寸

- (1) 0.96mm×0.96mm

3. 主要用途

- (1) 整流电源
- (2) 其他整流应用



4. 产品极限参数

参数名称	符号	单位	测试条件	数值
反向重复峰值电压	V_{RRM}	V	$T_j=25^{\circ}C, I_{RRM}=5\mu A$	1000
反向不重复峰值电压	V_{RSM}	V	$T_j=25^{\circ}C, I_{RRM}=5\mu A$	1100
正向平均电流	$I_{F(AV)}$	A		1
正向浪涌电流	I_{FSM}	A		30
电流时间积分	I^2t	A^2S		4.5
结温范围	T_j	$^{\circ}C$		-40 ~ 150

5. 其他检查标准

参数名称	符号	单位	测试条件	标准数值			检验数量
				最小值	典型值	最大值	
反向漏电流	I_R	μA	$V_R=1000V$	-	-	5	全数
		μA				150	抽检(5%)
正向压降	V_F	V	$I_F=1A, T_j=25^{\circ}C$, 芯片测试	-	0.97	1.05	全数
外观检验	(1) 玻璃裂纹			-	-	-	
	(2) 金属层侵蚀			-	-	-	

6. 芯片结构

名称	符号	单位	尺寸	说明
芯片尺寸	U	mm	0.96 ± 0.05	
沟槽尺寸	W	mm	0.76 ± 0.05	
金属尺寸	X	mm	0.72 ± 0.05	
芯片厚度	Y	μm	230 ± 10	
沟槽深度	Z	μm	75 ± 10	
AL金属层厚度		μm	7 ± 1	
Ti-Ni-Ag金属层厚		μm	$1.0 \sim 1.5$	

